Requested Patent:

JP63279228A

Title:

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE;

Abstracted Patent:

JP63279228;

**Publication Date:** 

1988-11-16;

Inventor(s):

NISHIKI TAMAHIKO; others: 01;

Applicant(s):

OKI ELECTRIC IND CO LTD;

Application Number:

JP19870112588 19870511;

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133; G09F9/30; H01L27/12;

Equivalents:

JP2521752B2;

ABSTRACT:

PURPOSE:To prevent the generation of a domain phenomenon by forming an insulating plate having a flat surface on a picture element electrode base and forming picture element electrodes to be connected to a switching element through a contact hole on the surface of the insulating layer.

CONSTITUTION: The insulating layer 57 for flatting a step difference due to the switching element 15 or the like is formed and the picture electrodes 51a, 51b are formed on the surface of the layer 57. Consequently, the generation of a domain phenomenon can be prevented. In addition, the electrodes 51 can be formed up to the upper area of source and gate electrodes 11, 13 by covering the element 15 and the source and gate electrodes 11, 13 with the layer 57. Thereby, an electric separation area is formed between picture element electrodes in which the domain phenomenon may be easily generated and to interrupt the domain phenomenon generated by the curve of lines of electric force by means of the electrode 11. Consequently, the domain phenomenon is not easily generated, and even if it is generated, its generation is not easily observed to improve contrast characteristics and visual field angle characteristics.

# 响日本国特許庁(JP)

#### 昭63-279228 ⑫公開特許公報(A)

၍Int.Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和63年(	198	8)11月16日
G 02 F 1/133 G 09 F 9/30 H 01 L 27/12	3 2 7 3 3 8	7370-2H K-7335-5C A-7514-5F	審査請求	未請求	発明の数	1	(全9頁)

49発明の名称 液晶表示装置

の出 願

願 昭62-112588 印特 願 昭62(1987)5月11日 23出

木 79発 明 者 西 みゆき 望月 ⑦発 明者 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

弁理士 大垣 30代 理

1.発明の名称 液晶表示装置

### 2.特許請求の範囲

(1) スイッチング装子が設けられた画業電極基 板と、共通電極基板とを具えるアクティブマトリ クス駆動型の液晶表示装置において、

前記画器電極基板面上に平坦表面を有する絶縁 層を設け、

該絶緣層の前記平坦表面上に該絶緣層に設けら れたコンタクトホールを介して前記スイッチング 素子に接続するように画素電極を設けて成ること を特徴とする液晶表示装置。

(2) 前記スイッチング素子のデータ電極の上方 の領域に前記画素電極の電気的分離領域を設けて 成ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の液晶表示装置。

# 3. 発明の詳細な説明

# (産業上の利用分野)

この発明は液晶表示装置に関するもので、特に 液晶の配向の不具合によって生ずる表示品質の悪 化を防止することが可能な液晶表示装置に関する ものである。

#### (従来の技術)

液晶表示装置はCRTに代るフラットパネル ディスプレイの一つとして期待されている。さら に、液晶表示装置は、発光を利用した他の種類の 表示装置に出し消費電力が極端に少ないため、電 池駆動の小型の表示装置例えば超小型テレビ等に 適していることから、この分野においても研究が 盛んに行なわれている。又、液晶パネルと、カ ラーフィルターとを組み合わせることによって鮮 やかなカラー表示が可能になることから、カラー 表示化の研究がなされ一部は実用化されている。

このような液晶表示装置を駆動する方法として は種々のものが考えられるが、近年主に行なわれ ている方法はアクティブマトリクス駆動法である といえる。

このようなアクティブマトリクス駆動法に適し た型の液晶表示装置は良く知られているが、以 下、第3図~第5図を参照して従来のこの種の液 晶表示装置の一般的な構造につき簡単に説明する。

第3図は従来のアクティブマトリクス型の液晶表示装置の、スイッチング素子が設けられた側の基板(画素電極基板と称することもある。)上の各構成成分の配置関係につき主に示す部分的平面図である。尚、この場合、スイッチング素子を薄膜トランジスタ(TFT)とした例で示してある。

第3図において、11はデータ電極としてのソース電極を示し、13は走査電極としてのゲート電極を示す。これら電極は例えばガラス基板等の好適な基板上にマトリクス状に形成されている。又、これら両電極が交差する領域にはTFT15が形成されていて、図中、17で示すものはこのTFT15のドレイン電極になる。このドレイン電極17には西素電極19(図中、斜線を付して示してある)が接続されている。

又、第4図は、第3図に示した画素電極基板を 第3図に示す I - I線に沿って切って概略的に示

それぞれ形成されている。これら基板21及び31間 には、液晶39が封入されている。

従来の液晶表示装置では、TFT15、走査電極(ゲート電極)13、又データ電極(ソース電極(シーク電極(ソース電極を)15が形成された領域は基板表面から突出してのため、モノカラーをでは、ス・モノカラーをでは、関係にカラーフィルター33を用いた場合にない、は、り合うカラーフィルター間に凹部43が生じいて、海の大手では、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、大利のでは、カウーでは、カウ

又、第3図からも明らかなように、従来の液晶 表示装置では、画素電極19がソース電極11やゲート電極13と短絡しないように、画素電極とこれら 電極とを離問させる必要があった。

ところで、上述したようなアクティブマトリク ス型の従来の液晶表示装置においては、液晶分子 した断面図である。尚、図面が複雑化することを 回避するため、断面を示すハッチングを一部省略 して示してある。

第4回において、21は基板としての例えばガラス基板を示す。23はゲート絶縁膜を、25はアモルファスSi腰を、27は保護膜をそれぞれ示す。

又、第5 図は第3 図及び第4 図を用いて説明した画素電極基板と、共通電極を有する別途用意でれた他方の基板(共通電極基板と称することもある)とを用いて構成された従来の液晶表示装置を機略的に示す断面図である。尚、第5 図に示るを被晶表示装置はカラー表示用のものの例である。 又、この図も図面が複雑化することを回避するため、断面を示すハッチングを一部省略して示してある。

第5図において、31は第二の基板を示す。この 基板31上には基板側からカラー表示用カラーフィ ルター33と、共通電極35とが順次に設けられてい る。又、図中37で示すものは配向膜であり、画案 電極基板21及び共通電極基板31の互いの対向面に

の一部の分子が、後述するような理由で所望の配向方向でない方向に配向すること(以下、これをドメイン現象と称することにする。)が起こり、これがため、表示品質が悪化することが生じていた。

ドメイン現象を生じさせる他の原因としては電気力線の曲りが考えられる。このことにつき第6因を参照して説明する。

アクテイプマトリクス型の液晶表示装置におい ては、多数のゲート電極を順次に選択し、選択さ れたゲート電極に所属する多数の画案のソース電 極にデータ信号がそれぞれ印加される。今、ある ゲート電極に所属する多数の画素を一つおきにオ ンさせ残りの画素をオフさせる場合を考える。第 6 図は従来の液晶表示装置をこのように駆動した 場合の電気力線の様子を模式的に示した図であ り、共通電極37に対し画素電極19が正電位となる ようにこの画案電極19に電圧を印加した場合を示 している。駆動されているTFTの画業電極と、 共通電極との間には本来は画素電極19から共通電 極37に向う電気力線が生じるはずであるが、駆動 されているTFTと、駆動されていないTFTの 画素電極との間にも不用な電気力線(第6図中、 41で示す電気力線の曲り)が生ずるものと思われ る。この不用な電気力線が生じている領域の液晶 分子の配向方向は、正常な電気力線が生じている 領域での配向方向とは異なるものになるから、こ れによってもドメイン現象が生じるものと思われ

位置合せさせるにはより正確なアライメントが必要になるから製造工程上好ましいことではない。 又、電気力線が曲った部分(第6図に41で示した部分)でのドメイン現象に対しては何等の対策もなされないことになり、この部分の液晶分子の配向の不具合によって表示品質が損ねられることになる。

この発明は上述したような点に鑑みなされたものであり、従ってこの発明の目的は、ドメイン現象が発生しにくく、又ドメイン現象が発生しても 視認されにくい液晶表示装置を提供することにある。

# (問題点を解決するための手段)

この目的の達成を図るため、この発明によれば、スイッチング案子が設けられた画葉電極基板と、共通電極基板とを具えるアクティブマトリクス駆動型の液晶表示装置において、

前述の画素電極基板面上に平坦表面を有する絶 縁層を設け、この絶縁層の前述の平坦表面上にこ の絶縁層に設けられたコンタクトホールを介して る。このような不用な電気力線はオン信号が印加されているデータ電極に沿って並ぶオフ状態の画 素電極の端部領域でも生じる。

# (発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上述したように、ソース電極と 画業電極との隙間を可能な限り直線状にすること は、液晶表示装置の画素配列の自由度を損ねるこ とになる。又、隙間同士が正確に対向するように

前述のスイッチング素子に接続するように画案電 種を設けて成ることを特徴とする。

この発明の実施に当たり、前述のスイッチング 素子のデータ電極の上方の領域に前述の画素電極 の電気的分離領域を設けるのが好通である。

尚、液晶表示装置がカラー表示可能なものであって、共通電極基板上にカラフィルターを有するものである場合には、共通電極基板のカラフィルタ上に、カラーフィルターと基板表面との間に構成される凹凸を平坦化する絶縁層を設け、この絶縁層上に共通電極を設けるのが好適である。

#### (作用)

このような構成によれば、スイッチング素子、スイッチング素子の走査電極、このスイッチング素子の走査電極基板表面で主に構成される凹凸を平坦表面を有する絶縁層で覆みないまることが出来る。従って、画素電極基板間の液晶封入用の空隙は両基板板間のどの部分においても実質的に均一寸法になるから、液晶分子を配向させるための種々の条件も均

B.

又、スイッチング素子やこれの走査及びデータ 電極が絶縁層で覆われているから、この絶縁層上 に設ける画素電極をこのスイッチング素子や両電 極が形成されている領域上方に至るまで形成する ことが出来るようになる。従って、隣接する画案 電極を電気的に分離するための分離領域を走査電 極上方の領域やデータ電極上方の領域に設けるこ とが出来るようになる。

この発明の好適例においては、隣接する画画案電極間の、スイッチング素子のデータ電極のスイッチング素子のデータ電極をこのデータ電極上方の絶縁層部分上の領域内に設けている。データ電極や走査電極に辿光性の虚気にすれば、の曲りに起因するドメイン現象が発生し対象が発生と呼びを表により覆うことが出来ない。このドメイン現象は表示装置をみるお

第1図(A)において、IIはデータ電極としてのソース電極を示し、13は走査電極としてのゲート電極を示す。これら電極は例えばガラス基板等の好適な基板上にマトリクス状に形成されている。又、これら両電極が交差する領域にはTFT15が形成されていて、図中、17で示すものはこのTFT15のドレイン電極になる。

認められないようになる。

#### (実施例)

以下、第1 図及び第2 図を参照してこの発明の アクティブマトリクス型の液晶表示装置の実施例 につき説明する。尚、以下の説明に用いる各図は この発明が理解出来る程度に概略的に示してある にすぎず、従って、この発明がこれら図示例にの み限定されるものでないことは理解されたい。 又、各図において、共通の構成成分については同 一の符号を付して示してある。さらに、従来 で 様な構成成分については従来の符号と同一の符号 を付して示してある。

#### 液晶表示装置の構成

第1図(A)はこの発明のアクティブマトリクス型の液晶表示装置の、スイッチング素子が設けられた側の基板(画案電極基板)上の各構成成分の配置関係につき主に示す部分的平面図である。 尚、この場合、スイッチング素子を薄膜トランジスタ(TFT)とした例で説明する。

ゲート電極13のストライプ方向に沿って直線的に並んでいる各画素電極51のうちの隣接する画素電極51間の、ソース電極のストライプ方向と平行方向の電気的分離領域55をソース電極11上方の領域にこのソース電極の形成領域内に納るように形成してある。従って、この場合の画素電極はTFT15が形成されている領域の上方にも存在するようになる。

第1図(B)は、第1図(A)に示した画素電 種基板を第1図(A)に示す II - II 線に沿って 切って概略的に示した断面図である。尚、図面が 複雑化することを回避するため、断面を示すハッ チングを一部省略して示してある。

第1図(B)において、21は基板としての例えばガラス基板を示す。23はゲート絶縁膜を、25はアモルファスSi腰をそれぞれ示す。又、57はソース電極11、ゲート電極13、TFT15及び基板表面で主に構成される凹凸を平坦化するための既に説明した絶縁層を示し、この絶縁層57のドレイン電極17上に該当する領域にはコンタクトホール

53を形成してある。

このようなこの発明の画素電極用基板と、従来の共通電極基板とを用いて、液晶表示装置を構成すれば、液晶表示装置がモノカラー表示のものであれば段差に起因するドメイン現象は全く生生ノカラー表示を問わず、電気力線の曲りに起とをしてきるドメイン現象はゲート電極によって遮蔽されるから、画素電極基板側から液晶表示装置を見る

# 液晶表示装置の製造方法

次に、この発明の液晶表示装置の理解を深めるため、第1図(B)及び第2図を参照してこの発明の実施例の液晶表示装置の製造方法の一例につき説明する。尚、以下に説明する材料、形成方法及び数値的条件等は単なる例示にすぎず、この発明がこれら材料、形成方法及び数値的条件に限定されるものでないことは理解されたい。

通常の薄膜形成技術を用い、ガラス基板21上に

者がこのドメイン現象を認めることはなくなる。

第2図において、31はガラス基板を示す。このガラス基板31上にはカラーフィルター33が設けられている。又、この発明に係る共通電極基板は、カラーフィルター33を含むガラス基板31上に、カラーフィルタ33及び基板31表面で主に構成される段差を平坦化するためこの段差を覆い平坦表面を有する絶縁層61と、この絶縁層61上に設けられた共通電極37とを具えている。

第1図(A)及び(B)に示したような画素電

スイッチング素子としてのTFT15、これの走査電極13及びデータ電極11を形成する。この工程は従来のアクティブマトリクス型の液晶表示装置の製造方法を用いることが出来る。

次に、TFT15及び両電極13.11 が形成された ガラス基板21上に平坦表面を有する絶縁層57の形成を行なう。この実施例の場合、この絶縁層57の 形成を以下のように行なった。

のになった。尚、上述のポリイミドワニスの成膜 条件は、TFT等の形状、用いるワニスの粘度等 を考慮して決定されるべきもので、この実施例の 条件に限定されるものではない。さらに、絶縁層 57を構成する材料についても、実施例のポリイミ ドワニスに限定されるものではなく、他の好適な 材料を用いることが出来る。

次に、上述の如く形成した絶縁層57に対し加工を行なう。この実施例の場合の加工は、TFT15のドレイン電極に対応する領域にコンタクトホール53を形成すること、及び別途用意された駆動素子に走査及びデータ電極を接続するためこれを動力を発している。これら加工は通常のフォトエッチング技術を用いてレジストマスクを形成し、日産化学社製サンエバー専用のエッチング液及びリンスを用いて地線層57の不用部分部分を除去することで行なった。

次に、この絶縁層57上に例えばRFスパッタ法等の好適な方法によって、ITO膜を約1000

の発明に係る液晶表示装置を得た。

尚、この発明は上述した実施例に限定されるものではない。

又、上述の実施例においては、スイッチング素 子をTFTとした例で説明している。しかし、ス イッチング素子をダイオード或はMIM (Metal Aの膜厚に形成し、次に、このITO膜をフォトエッチング技術によって所定形状(第1図(A)参照)に加工して画案電優51を形成し、第1図(A)及び(B)に示すようなこの発明に係る画素電優基板を得た。

一方、第2図を用いて既に説明した共通電極基 板を次のように形成した。

ガラス基板31上に従来公知の方法でカラーフィルタ33を形成する。この場合も、カラーフィルタ33表面と、基板表面との間には約2μmの段差が構成される。画案電極基板を形成したときと同様にサンエバー120を用い同様な成膜条件で平坦化を行ない、サンエバー120の不用部分を画案電極基板形成時と同様に除去して、絶縁層69を形成した。この絶縁層69上に従来公知の方法で共通電極37を形成した。

上述の如く形成した画素電極基板と、共通電極 基板とに対し配向処理を行ない、その後、これら 基板をスペーサを介して貼り合わせる。基板間の 空難に液晶を封入した後、封入口を封止して、こ

Insulator Metal )等の他の非線形スイッチング 素子として構成した液晶表示装置に対してもこの 発明を適用出来ることは明らかである。

#### (発明の効果)

上述した説明からも明らかなように、この発明の液晶表示装置は、スイッチング素子等に起因する段差を平坦化する絶縁層を具え、この絶縁層上に画素電極を具えている。このため、ドメイン現象が生じにく、かつ、液晶の封入・時に気泡が発生しにくい。さらに、面素電極とソース電極との間の隙間を直線的にするようなことをせずともドメイン現象の発生を防止することが出来るから、画素配列の自由度が損なわれることもない。

又、スイッチング案子やソース及びゲート電極を覆うように絶縁層を設けることが出来るから、 ソース電極やゲート電極の形成されている上方領域にまで画素電極を形成することが出来るように なる。このため、ドメイン現象が生じ易い領域で ある画素電極間の電気的分離領域を例えばソース 電極上方に形成して、電気力線の曲りによって生 じるドメイン現象をソース電極によって進蔽する ことが出来る。

これがため、ドメイン現象が発生しにくく、又 ドメイン現象が発生しても視認されにくい液晶表 示装置を提供することが出来、よって、この発明 の液晶表示装置は従来のものよりもコントラスト 特性、視野角特性が向上する。

# 4.図面の簡単な説明

第1図(A)及び(B)は、この発明の液晶表示装置の説明に供する要部平面図及び断面図であって、画案電優基板の一部を示す平面図及び断面図、

第2図は、この発明の液晶表示装置の説明に供する要部断面図であって、共通電極基板の一部を示す断面図、

第3図~第5図は従来の液晶表示装置の説明に 供する図であって、第3図及び第4図は画素電極 基板の一部を示す平面図及び断面図、第5図は液 晶表示装置の一部を示す断面図、

第6図は従来及びこの発明の説明に供する図で

ある.

11 ··· データ電極(ソース電極)
13 ··· 走査電極(ゲート電極)
15 ··· スイッチング素子
17 ··· ドレイン電極、 23 ··· ゲート絶縁膜
25 ··· アモルファスSi、51、51a、51b ··· 画素電極
53 ··· コンタクトホール
55 ··· 画素電極間の電気的分離領域

特 許 出 願 人 沖電気工業株式会社

風報與極

データ電径 (ソース電極)

代理人 弁理士 大 垣

57、61 …平坦表面を有する絶縁層。



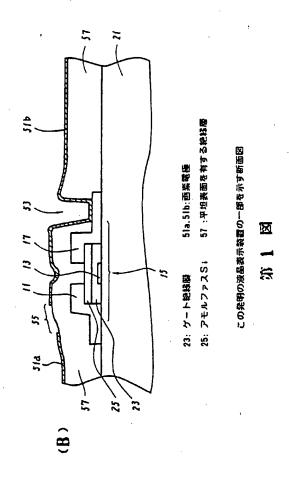
走査電極 (ケート電極) 53:コンタクトホースイッチング素子(TFT) 55: 画素電極間のドレイン電極

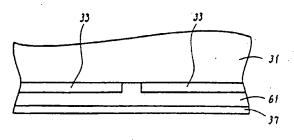
5. 5.

この発明の液晶表示装置の一部を示す平面図

図

紙

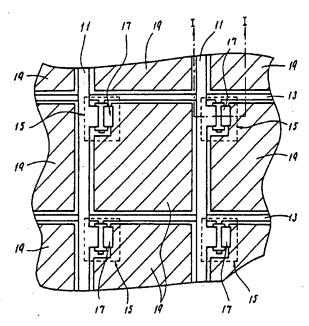




61: 平坦表面を有する絶縁層

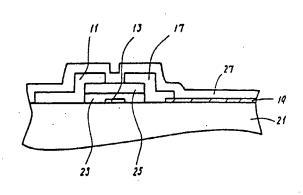
この発明の液晶表示装置の一部を示す断面図

第2図



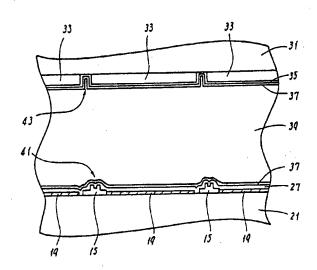


第 3 図



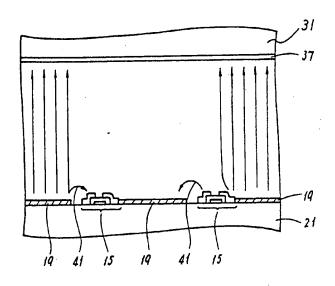
従来の液晶表示装置の説明に供する断面図

第 4 図



従来の液晶表示装置の説明に供する図

第 5 図



従来及びこの発明の説明に供する図

# 第6図